# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-232465

(43)Date of publication of application: 10.09.1993

(51)Int.CL

G02F 1/1335

G02F

1/1333

(21)Application number: 04-031127

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

19.02,1992

(72)Inventor:

SHIMADA YASUNORI

TANIGUCHI KOJI TANAKA HIROHISA **NAKAMURA HISAKAZU** 

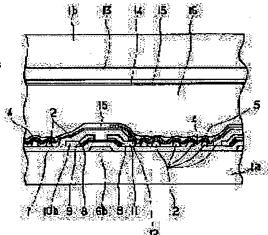
MITSUI SEIICHI KIMURA TADASHI

### (54) REFLECTION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the contrast of the reflection type liquid crystal display device by obtaining reflection plates having uniform light scatterability and good reflection characteristics.

CONSTITUTION: This liquid crystal display device is constituted by having an insulating substrate 1b on which transparent electrodes 14 are formed, an active matrix substrate 1a which is constituted by forming pixel electrodes consisting of reflection films 5 on a substrate having many pieces of fine ruggedness including curved surface parts consisting of first films 2 having ruggedness and second films 4 formed by applying liquid on the first films 2 and curing the liquid and a liquid crystal layer 16 which is encapsulated between the insulating substrate 1b and the active matrix substrate 1a. The liquid for forming the second films 4 is applied on the first films 2 having many pieces of the fine ruggedness and curing the coating, by which the above-mentioned ruggedness having the plane parts are made into the ruggedness having the curved surface parts. The light scattering characteristic of the reflection films 5 formed thereon is thereby improved.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

26.01.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2756206

[Date of registration]

06.03.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

27.09.1999

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-232465

(43)公開日 平成5年(1993)9月10日

(51) Int. C1. 5

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G 0 2 F

1/1335

520

7811 - 2 K

1/1333

500

9225 - 2 K

審査請求 未請求 請求項の数7

(全7頁)

(21)出願番号

特願平4-31127

(22)出願日

平成4年(1992)2月19日

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 島田 康憲

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 谷口 幸治

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72) 発明者 田中 広久

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

.(74)代理人 弁理士 梅田 膀

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】反射型液晶表示装置及びその製造方法

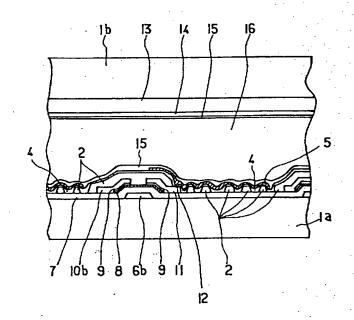
#### (57)【要約】

【目的】 反射型液晶表示装置において、コントラストを向上させる。

【構成】 透明電極14が形成された絶縁性基板1b と、凹凸を有す第1膜2と該第1膜2に液体を塗布、硬 化することによって形成された第2膜4よりなる曲面部 を含む多数の微細な凹凸を有する基板上に、反射膜5か らなる画素電極を形成したアクティブマトリクス基板

(基板1a)と、該絶縁性基板1bと該アクティブマトリクス基板(基板1a)との間に封入された液晶層16と、を備えてなる反射型液晶表示装置である。

【効果】 多数の微細な凹凸を有する第1膜2上に第2膜4とする液体を塗布、硬化することによって、平面部を有していた前記凹凸は曲面部を有する凹凸になり、これによってこの上に形成される反射膜5の光散乱特性が向上する。





多数の微細な凹凸を形成し、更にその上に銀等の反射膜を形成して反射板とする方法が提案されている。図5及び図6にこのような反射板の構造を備えたアクティブマトリクス方式の反射型液晶表示装置の構造を示す。

【0007】図5はアクティブマトリクス側の基板1aの平面図であり、図6は図5のY-Y'線断面図である。ここではこの方式に用いられるスイッチング素子として、薄膜トランジスタ(以下、TFTと略す。)を用いている。

【0008】ガラス等の基板1a上に、クロム、タンタ ル等からなる複数のゲート配線6aが設けられ、ゲート 配線6aからはゲート電極6bが分岐して設けられてい る。ゲート配線 6 a は走査線として機能している。ゲー ト電極6bを覆って基板1a上の全面に窒化シリコン (SiNx)、酸化シリコン (SiOx) 等から成るゲ ート絶縁膜7が形成されている。ゲート電極6bの上方 のゲート絶縁膜7上には、非晶質シリコン(以下、a-Siと略す)多結晶シリコン(以下、p-Siと略 す)、CdSe等から成る半導体層8が形成されてい る。半導体層8の一方の端部には、チタン、モリブデ ン、アルミニウム等から成るソース電極10bが重畳形 成されている。図5に示すように、ソース電極10bは ソース配線10aから分岐したものである。また、半導 体層8の他方の端部には、ソース電極10bと同様にチ タン、モリブデン、アルミニウム等から成るドレイン電 極11が形成されている。ドレイン電極11上を除く部 分の上層には第1膜2が形成され、これをエッチング法 を用いて多数の微細な凹凸に加工されている。ドレイン 電極11の半導体層8と反対側の端部には、アルミニウ ム、銀等の金属から成る反射膜5が重畳されている。こ の反射膜5が画素電極となる。 ゲート電極6 b、ゲー ト絶縁膜7、半導体層8、ソース電極10bおよびドレ イン電極11はTFTを構成し、該TFTは、スイッチ ング素子の機能を有している。

【0009】このように作成したアクティブマトリクス 基板と透明電極を有する対向基板との間に液晶を封入し て貼り合わせ、反射型液晶表示装置とする。

【0010】この反射型液晶表示装置では、対向基板側から入射した外部光をアクティブマトリクス基板の反射膜5で反射し、液晶層を通過した反射光を対向基板側から見ることになる。

【0011】以上のようにTFTを形成した基板1 a 上に第1膜2を形成すれば、エッチング法を用いて第1膜2で多数の微細な凹凸を容易に形成することができ、この凹凸を有する基板1 a 上に金属等で反射膜5を形成することによって、容易に反射板として機能する凹凸を有する画素電極を得ることができる。

【0012】上記のような反射板として機能する凹凸を 有する画素電極を形成するプロセスをより詳しく説明す る。図7は図6のA部分のプロセスを説明するための図 である。まず、基板1 a 上のゲート絶縁膜7の上に第1 膜2を形成する(図7(a))。次にその上にフォトレジスト3を塗布し、所定の形状にパターニングし(図7(b))、第1膜2をエッチングすることによって多数の微細な凹凸を作成する(図7(c))。そしてフォトレジスト3を剥離し、凹凸を有する基板1 a に画素電極となる反射膜5を形成する(図7(d))ことにより完了する。

#### [0013]

0 【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のような方法で反射膜5を形成すると図7 (d) に示すように図7 (c) の時点でフォトレジストの残っていた凸部5a及び絶縁膜2aが取り除かれた凹部5bは、平面的でありその反射光は正反射成分を多く含むことになり、鏡面状態に近い。

【0014】エッチングを工夫することにより斜面の部分を増減することは可能であるが、平面部分は残る。 又、第1膜のエッチングを途中で止めて下地のゲート絶縁膜7を表さないようにすることもできるが、エッチングの基板内面分布によりエッチング形状が異なり、面内で反射特性が異なる等の問題が発生する。

【0015】本発明の目的は、上記問題点に鑑み、均一で光散乱性のよい反射特性を有する反射板を備えた、コントラストの高い反射型液晶表示装置及びその製造方法を提供することにある。

#### [0016]

【課題を解決するための手段】本発明の反射型液晶表示 装置は、凹凸を有する第1膜と該第1膜に液体を塗布、 硬化することによって形成された第2膜よりなる曲面部 を含む多数の微細な凹凸を有する基板上に反射膜からな る電極を形成した反射板と、該絶縁性基板と該反射板と の間に封入された液晶層と、を備えてなることを特徴と するものである。

【0017】また、本発明の反射型液晶表示装置は、透明電極が形成された絶縁性基板と、凹凸を有する第1膜と該第1膜に液体を塗布、硬化することによって形成された第2膜よりなる曲面部を含む多数の微細な凹凸を有する基板上に、反射膜からなる画素電極を形成したアクティブマトリクス基板と、該絶縁性基板と該アクティブマトリクス基板との間に封入された液晶層と、を備えてなることを特徴とするものである。

【0018】ここで前記第1膜または、前記第2膜はアクティブマトリクス基板上のスイッチング素子の保護膜とすることもできる。

【0019】また、前記第1膜を感光性樹脂で構成することもできる。

【0020】また、本発明の液晶表示装置の製造方法 は、多数の微細な凹凸が形成された基板上に反射膜から なる電極を形成した反射板を有する反射型液晶表示装置 の製造方法であって、該反射板を構成する基板の一方面



る。但しこの場合には、第2膜4を形成した後に、第2 膜4上に形成する反射膜5とTFTのドレイン電極11 とを電気的に接続するためのコンタクトホール12を形 成しなければならない。

【0033】基板1aと対向する絶縁性基板1bにはカラーフィルター13が形成される。カラーフィルター13上の全面にはITOなどからなる透明電極14が形成される。両基板は、さらに配向膜15が形成され、対向して貼り合わせられ、間に液晶層として黒色色素を混入した相転移型ゲスト・ホスト方式用の液晶を封入して偏光板を必要としない反射型液晶表示装置が完成する。

【0034】この反射型液晶表示装置では、対向する絶縁性基板1b側から入射した外部光を基板1a上の反射膜5で反射し、液晶16を通過した反射光を絶縁性基板1b側から見ることになる。

【0035】この反射型液晶表示装置の画素電極は均一 で光散乱性のよい反射特性を有しており、これによって 良好なコントラストを実現することができる。

【0036】本実施例では、スイッチング素子としてTFTを用いた場合について説明したが、ダイオード、バリスタ、MIM素子等がスイッチング素子であってもかまわない。また、スイッチング素子を用いない単純マトリクス方式であっても良い。

【0037】また、本実施例では基板1a側に画素電極として、反射板構造を設けたが、画素電極を透明電極とし、対向する絶縁性基板1b側の電極をに反射板構造としてもよい。ただし、カラーフィルター13は基板1a側に設ける。

【0038】この場合には、基板1a側から入射した外部光を対向する絶縁性基板1b上の反射膜で反射し、液晶層16を通過した反射光を基板1a側から見ることになる。

【0039】尚、表示モードとしては、本実施例で用いた相転移型ゲスト、ホストモードの他に、2層式ゲス

ト. ホストモードのような光吸収モード、高分子分散型 LCDのような光散乱型表示モード等の表示モードを採 用することもできる。

#### [0040]

【発明の効果】本発明によれば、均一で光散乱性のよい 反射特性を有する反射板が得られるので、液晶表示装置 のコントラストを向上させることができる。

【0041】又、第1膜に感光性樹脂を用いたり、また、アクティブマトリクス方式の反射型液晶表示装置の場合、第1膜または、第2膜を保護膜とすることで、プロセスが簡略化し、コストの低減や歩留まりの向上を図ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の反射型液晶表示装置における反射板の製造プロセスを説明するための図である。

【図 2 】他の反射板の製造プロセスを説明するための図 である。

【図3】本発明の一実施例を示すアクティブマトリクス 方式の反射型液晶表示装置の断面図である。

20 【図4】図3に示されるアクティブマトリクス基板の平面図である。

【図5】従来の反射型液晶表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の平面図である。

【図6】同図のY-Y'線断面図である。

【図7】従来の反射板の製造プロセスを説明するための 図である。

#### 【符号の説明】

1. 1 a 基板

1 b 絶縁性基板

30 2 第1膜

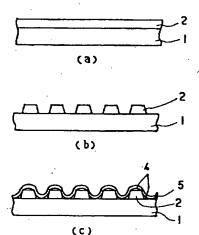
4 第2膜

5 反射膜

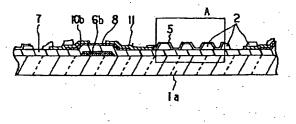
14 透明電極

16 液晶層

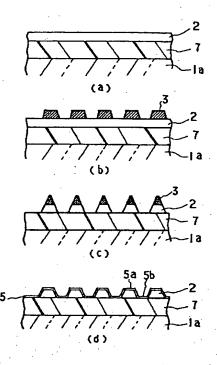
【図2】



【図6】



# 【図7】



## フロントページの続き

(72)発明者 中村 久和

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72)発明者 三ッ井 精一

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 木村 直史

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内